

[第9図] 2SK63

2SK63は、選択酸化法を採用した縦形FETです。

特長は

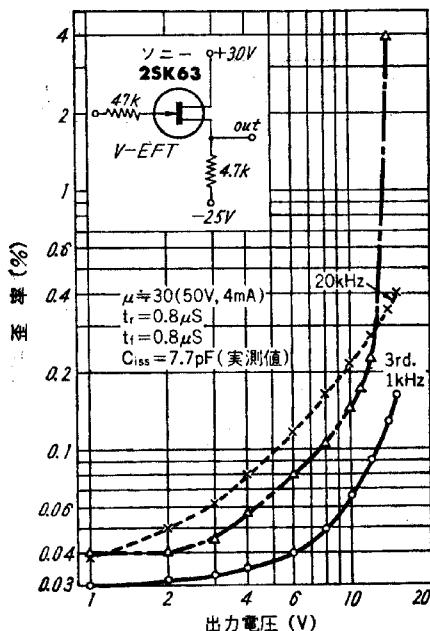
小信号電圧増幅用FETであり、高入力インピーダンスをもつ直線性の良い三極管特性 スイッチング特性が良好

1. 構造 Nチャンネル接合形シリコン電界効果トランジスタ
2. 用途 小信号電圧増幅
3. 外形 TO-5
4. 絶対最大定格 (Ta=25°C)

ゲート・ドレイン間電圧	V _{DGO}	120V
ゲート・ソース間電圧	V _{SGO}	10V
ドレイン電流	I _D	200mA
ゲート電流	I _G	20mA
許容電力損失	P _T	470mW (Ta=25°C)
接合部温度	T _j	120°C
保存温度	T _{stg}	-50~+150°C

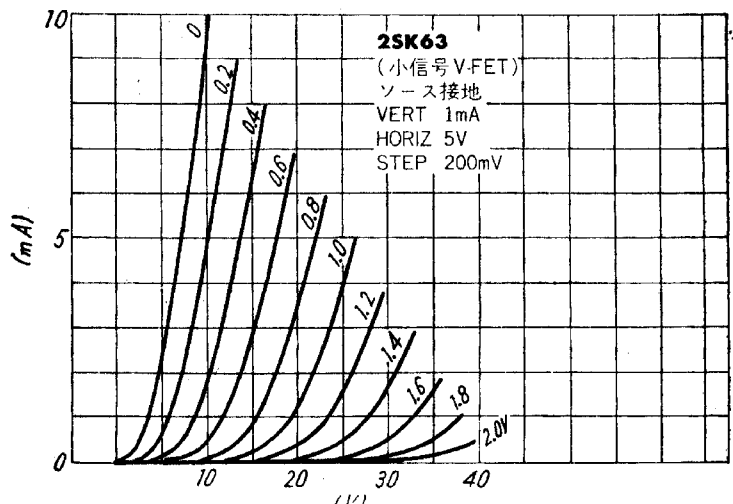
5. 電気的特性 (Ta=25°C)

項目	記号	条件	最小値	標準値	最大値	単位
ドレイン・ゲート間電圧	V _{DGO}	I _D =0.1mA	120			V
ソース・ゲート間電圧	V _{SGO}	I _S =0.1mA	10			V
ドレイン・ゲート間漏れ電流	I _{DGO}	V _{DG} =50V, I _S =0A			200	nA
ゲート漏れ電流	I _{GSS}	V _{GS} =6V, V _{DS} =0V			200	nA
オン電圧	V _{on}	V _{GS} =0.3V, I _D =7mA			10	V
カットオフ電圧	V _P	V _{DS} =100V, I _D =300μA		-4.5	-9.5	V
電圧増幅率	μ	V _{DS} =50V, I _D =4mA f=1MHz	15	30		
順方向伝達アドミタンス	g _m	V _{DS} =50V, I _D =4mA f=1kHz		14		mS
入力容量	C _{ip}	V _{DS} =50V, I _D =4mA f=1kHz		16		pF
出力インピーダンス	r _o	V _{DS} =50V, I _D =4mA		2		kΩ
	C _p	f=1MHz		4		pF
熱抵抗	θ _{j-a}				200	°C/W
雑音指数	NF	V _{DS} =50V, I _D =4mA R _g =500kΩ, f=10Hz			30	dB



[第29図] V-FET 2SK63

ソース・フォロア



[第30図] 2SK63の静特性